PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication numb r:

02-066873

(43)Date of publication of application: 06.03.1990

(51)Int.CI.

H05B 33/26 G09F 9/30

G09F 9/30

(21)Application number: 01-162808

(71)Applicant: EASTMAN KODAK CO

(22)Date of filing:

27.06.1989

(72)Inventor: SCOZZAFAVA MICHAEL

(30)Priority

Priority number: 88 211616

Priority date : 27.06.1988

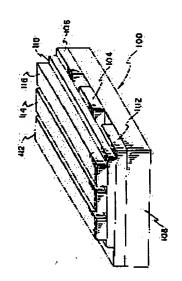
Priority country: US

(54) ELECTROLUMINESCENCE DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To form a very minute pixel region in an electroluminescence device by relatively positioning the strips of a cathode and an anode through an lectroluminescence medium so as to overlap them and partly offset them transversely.

CONSTITUTION: An anode comprises transparent metal strips 102, 104 and 106 which are arranged parallel at intervals below 400 μ m. m. An organic electroluminescence medium 110 is arranged over the anode strips. A cathode comprises metal strips 112, 114 and 116 which are transversely arranged parallel at intervals below 400 μ m. The strips of the anode and the cathode forming a row and a line are relatively arranged so as to overlap with each other and be partly offset transversely. The medium 110 in the constitution forms a luminescence region between the electrodes for receiving movable charge carriers from the electrodes. That arrangement allows a pixel size considerably smaller than that obtained by means of a shadow mask.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examin r's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平2-66873

(1) Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)3月6日

H 05 B 33/26 G 09 F 9/30

3 4 3 3 6 5

6649-3K 8838-5C 8838-5C

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全33頁)

❷発明の名称

電界発光デバイス

②特 願 平1-162808

②出 願 平1(1989)6月27日

優先権主張

1988年6月27日1982日1616 (US) 1988年6月27日1988年6月27日1988年11616 (US) 1988年6月27日1988年11616 (US) 1988年6月27日1988年11616 (US) 1988年11616 (

個発 明 者

マイケル スコツザフ

アメリカ合衆国, ニューヨーク 14613, ロチエスター,

エイバ

セネカ パークウエイ 740

勿出 顋 人

イーストマン コダツ

アメリカ合衆国, ニューヨーク 14650, ロチエスター,

ク カンパニー

ステイト ストリート 343

四代 理 人

弁理士 青木

外3名

明 田 書

1. 発明の名称

電界発光デバイス

2. 特許請求の範囲

1. アノード、前記アノード上に塗被せしめられた平面電界発光媒体、および前記平面電界発光 媒体上に塗被せしめられたカソードを有する電界 発光デバイスであって、

前記平面電界発光媒体が前記アノードに隣接せる有機正孔注入帯域と前記カソードに隣接せる有機電子注入発光帯域とからなり、

前記アノードが前記有機正孔注入帯域に接触せる多数個の横方向に間隔をあけて配置されたストリップからなり、その際、前記ストリップの中心間間隔は 400 m 未満であり、

前記カソードが前記有機電子注入発光帯域に接触せる多数個の機方向に間隔をあけて配置されたストリップからなり、その際、前記ストリップの中心間間隔は 400 扇未満であり、そして

前記カソード及びアノードのストリップが相対

的に整列せしめられていて、互いに関して、一部 は重畳しておりかつ一部は横方向にずれているこ とを特徴とする電界発光デバイス。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、ELデバイスとしても知られている 電界発光あるいは電場発光(エレクトロルミネッセンス)デバイスに関する。さらに詳しく述べる と、本発明はマトリクスアドレス方式の有機EL デバイスに関する。

〔従来の技術〕

フラットパネル表示で使用するためのマトリクスアドレス方式の無機電界発光デバイスは文献に記載されている (例えば、L.B.Tannas, Jr., *Flat Panel Displays and CRTs*, Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1984 の特に第8節を参照されたい)。これらのデバイスでは、2個の無機誘電体層の中間に介在せしめられた、例えばZnSiMn 系蛍光体のような多結晶無機蛍光体の環膜に電界

ELデバイスに有機電界発光材料を使用することは20年間以上にわたって知られており、また、例えばGurneeらの米国特許第 3.172.862号(1965年3月9日発行)に記載されている。有機ELデバイスについて記載したその他の早期の文献には次のようなものがある:Gurneeの米国特許第 3.173.050号(1965年3月9日発行); Dresner, *Double Injection Electroluminescence in

(3)

らの米国特許第 4,720,432号。

これらの最近の改良の結果、有機としデバイスを実際に使用する機会が増大した。しかし、現在までのところ、マトリクスアドレス方式の有機 ヒレデバイスは入手可能となっていない。特に、小さなピクセル表示を行うことが可能な有機とし デバイスの製作は実現されていない。

 Anthracene*, RCA Review, Vol.30, pp.322~334, 1969: およびDresner 、米国特許第 3.710.167号 (1973年1月9日発行)。

有機ELデバイスの製作の分野における最も最 近の発見としては、アノード(陽極)およびカソ ード(陰極)を分離している2つの極めて薄い層 (膜厚の合計がく1.0㎞)をもったELデバイス からのものがある。このELデバイスにおいて、 一方の層は特に正孔(ホール)を輸送するために 選ばれ、そして他方の層は特に電子を輸送しかつ デバイスの有機発光帯域として作用させるために 選ばれる。このデバイスの場合、先ず最初に、駆 動電圧を例えば電界効果型トランジスタの集積回 路駆動装置との適合性を満足させる範囲にまで低 下させることが可能であった。同時に、これらの 低駆動電圧の場合には、その光の出力でもって、 通常の周囲照明条件下において表示の観察を行う ことが十分に可能であった。以下に典型的な特許 を列挙する:Tangの米国特許第 4,356,429号、Van Slykeらの米国特許第4,539,507号およびVan Slyke

(4)

〔発明が解決しようとする課題〕

本発明の目的は、したがって、電極のラインが 非常に微細でありかつピクセルのサイズが小さく、 そして有機層の損傷を伴なわずに加工を行うこと が可能な新規なマトリクスアドレス方式の有機 ELデバイスを提供することにある。

[課題を解決するための手段]

上記した目的は、本発明によれば、アノード、 前記アノード上に塗被せしめられた平面電界発光 媒体、および前記電界発光媒体上に塗被せしめら れたカソードを有する電界発光デバイスであって、

前記平面電界発光媒体が前記アノードに隣接せる有機正孔注入帯域と前記カソードに隣接せる有機電子注入発光帯域とからなり、

前記アノードが前記有機正孔注入帯域に接触せる多数個の機方向に間隔をあけて配置されたストリップからなり、その際、前記ストリップの中心間間隔は 400 m未満であり、

前記カソードが前記有機電子注入発光帯域に接

触せる多数個の機方向に間隔をあけて配置された ストリップからなり、その際、前記ストリップの 中心間間隔は 400 ma未満であり、そして

前記カソード及びアノードのストリップが相対 的に整列せしめられていて、互いに関して、一部 は重量しておりかつ一部は積方向にずれているこ とを特徴とする電昇発光デバイスによって達成す ることができる。

本発明の好ましい態様において、記載のELデバイスは、有機のマトリクスアドレス方式のデバイスばかりではなくて、次のような特徴の1つもしくはそれ以上も包含する:

a)正孔注入帯域とカソードの間の発光帯域の 形成が、正孔及び電子の注入の両者を持続することができる有機ホスト物質と正孔一電子再結合に 応答して光を放射する蛍光物質とを有する1 mm未 満の厚さをもった薄膜により行われること。この 酸様では、光出力の波長が広範囲でありかつ安定 性が高レベルである有機のマトリクスアドレス方 式のデバイスが提供される。

(7)

の好ましい態様では、分光選択性が可能となる。 さらにまた、本発明では、その好ましい態様において、有機のマトリクスアドレス方式のELデバイスの利点、ならびに前記項目a),b)及びc)において示した追加の利点の1つもしくはそれ以上がもたらされる。以下により詳細に記載するけれども、この新しいタイプのデバイスの場合、有機ELデバイスの加工に適当であると今まで考えられなかった加工技術を用いてそれを製造することが可能になる。

第1図は、本発明のマトリクスアドレス方式有機電界発光(またはEL)デバイスの一部分を略示したものである。このデバイスにおいて、アードは、多数個の、機方向に間隔をおいて配置された、平行な、導電性の、透明な金属ストリップは透明なガラス基板108 上に支承されている。アノードストリップの上には、アノードストリップをカソードから分離するところの有機電界発光媒体110 が同一平面上に存在する。カソ

b) アノードに接触せる正孔注入帯域に正孔注入ポルフィリン系化合物を含ませ、正孔輸送芳香族アミンを含有する層を正孔注入化合物と電子注入 域の間に介在させること。この態様では、安定性の改良と運転性能の持続という追加の利点が 得られる。

c) マトリクスアドレス方式のデバイスのカソードストリップが種々の金属(アルカリ金属を除く)を有し、そして該金属の最低1種類が4eV未満の仕事関数を有すること。本発明のこの態様では、カソード及びデバイス全体のすぐれた安定性といった追加の利点が得られる。

この新しいタイプのBLデバイスによって、従来得ることができなかった貴重な性質の組み合わせを得ることができる。このデバイスでは、小サイズのピクセルをもったフラットパネル設示においてマトリクスのアドレシングが可能となる。さらに加えて、有機電気発光媒体は極めて薄となる。することができ、したがって低電圧が可能となる。また、特に発光帯域に蛍光物質を含ませる本発明

(8)

ードは、多数個の、機方向に間隔をおいて配置さ れた、平行な、導電性の金属ストリップ112、114 及び116 の形をしている。アノードとカソードの ストリップは、したがって、行及び列を構成して おり、また、相対的に配列せしめられていて、互 いに関して、一部は重量しておりかつ一部は機方 向にオフセットして、すなわち、ずれている。第 1 図に示されるように、アノードストリップの主 軸は平行であり、また、カソードストリップの主 軸も平行である。アノードストリップの主軸は、 平面有機電界発光媒体に対して垂直な方向から見 た場合、カソードストリップの主軸に角度をつけ て整列せしめられており、したがって、アノード 及びカソードストリップの主軸は互いに垂直であ る。しかし、アノード及びカソードストリップの 望ましい部分重畳と部分オフセットの関係は、そ れらのストリップの相対的な角度整列を図示した 垂直関係とは別のものとする場合に、例えば、ア ノード及びカソードストリップ主軸を30°~ 150° の角度でもって互いに角度をつけて整列する場合

に、達成することができる。アノード及びカソード及びカソード及びカリップは、この図面に示されて接続することができる。 この電源は、連続した直流の電源であることができる。 この電源であることができる。 なからしば、不連続の電源であることができるのであることができる任意の好都を合む)を使用することができる。アノード又はカソードのいずれかー方を接地電位とすることができる。

第1図において、平面電界発光媒体110 は、その簡略化のために単一の層として示されている。この電界発光媒体のことを "平面" と呼んでいるけれども、それは、この媒体の厚みがその長さ及び幅に比較して非常に小さいからである。第2図及び第3図を参照して以下に詳細に記載するけれども、この平面の電界発光媒体110 は、多数の層又は帯域を有することができ、また、それが好ましい。

(11)

電極の逆バイアスの印加は、可動電荷の移行の 方向を逆転させ、電荷の注入を中断し、そして光 の放射を終らせる。有機ELデバイスを操作する 最も普通のモードは、順方向バイアス印加の直流 電源を用い、そして光の放射を調節するのに外部 電流の中断または変調に頼ることである。

本発明のマトリクスアドレス方式のデバイスにおいて、例えば電気駆動装置のような電源は、アノード及びカソードの行と列によって形成された格子を介して電荷を供給する。ピクセルは、それぞれの行と列が交わったところ、すなわち、アノード及びカソードストリップが重量せる個所である。ピクセルは、交点にある軸に電荷を与えてしきい値電圧とした場合に発光する。

本発明の有機とレデバイスにおいて、有機電界発光媒体の全体の厚さを1 mm(10000Å) 未満に制限することによって、電極間で比較的に低い電圧を使用しながら、有効な光放射に一致するところの電流密度を保持することが可能である。1 mm未満の厚みにおいては、20ボルトの印加電圧は2×

ELデバイスは、そのアノードがカソードに較 べてより高電位である時、順方向バイアスをかけ たダイオードとして見ることができる。これらの 条件の下において、アノードは正孔(正電荷キャ リア)を平面電昇発光媒体中へ注入し、一方、カ ソードは電子を平面電界発光媒体中へ注入する。 アノードに接する電界発光媒体の部分したがって 正孔注入及び翰送帯域を形成し、一方、カソード と接する発光媒体の部分は電子注入及び輸送帯域 を形成する。注入される正孔と電子は各々、反対 の電荷をもつ電極の方へ移行する。これは有機電 界発光媒体内の正孔及び電子の再結合をもたらす。 正孔の充塡時、移行電子がその伝導電位から価電 子帯へ落ち込む時にエネルギーが光として放出さ れる。従って、有機電界発光媒体は、電極間で、 可動性電荷キャリヤを各電極から受取る発光帯域 を形成する。代替構造の選択に応じて、放出光は、 アノードを通して、あるいはカソードを通して、 あるいはこれらの両者を通して、電界発光材料か ら放射させることができる。

(12)

10° ボルト/cmより大きい電界電位をもたらし、これは有効な光放射に一致する。以下でより特定的に記述する通り、有機電界発光媒体の好ましい厚さは 0.1~0.5 mm(1000~5000 Å)の範囲にあって、印加電圧をさらに下げることおよび/または電界電位を増大させることを可能とするけれども、これらのことはデバイス組立ての可能性の範囲に十分に含まれるものである。

光透過性の電極を形成するため、有機電界発いは 媒体の上および/または独立した半透明ある体108 の上に多数個の半透明あるののである。 の上に多数個の半透明あるののである。 の上に多数個の半透明のでののののののである。 の上に多数個の半透明のでのでのである。 の上に多数個の半透明のでのでのである。 の上に多数個の半透明では、 できる。いはないとはではででではないできる。 のバランスすることにででではないできる。 のバランスははできる。 のバランスは、 できる。 できる。 とことである。 のバランスははないないでである。 のバランスはないなでである。 のバランスははないでである。 のがっている。 といいうことであるいなにないないでである。 にないれるにないないで便利と思われるより大きできる。 を使用できる。

第1図に示されるBLデバイス100、そしてこ のようなデバイスのなかの第2図に断面で示され るようなピクセル200 は、本発明の好ましい1歳 様を図示したものである。有機ELデバイスの歴 史的発展のゆえに、光透過性のアノードを用いる ことが慣用の方法である。これは、導電性の比較 的高い仕事関数の金属または金属酸化物の透明層 を上に沈着させてアノードを形成させた光透過性 の絶縁性支持体第1図の108 および第2図の201 を提供することによって達成される。 第1図に示 されるように、アノードは、公知な手法によって パターン状のストリップ102, 104及び106 として 形成される。支持体が透明なガラス板である場合、 常用のホトリソグラフィーを使用することができ る。なぜなら、ガラスやこのような不透質のプラ スチックスは常用のホトリソグラフィー用現像溶 媒によって損傷を被らないからである。このよう なストリップの断面203 は第2図に示してある。 有機電界発光媒体のアノードに直に隣接する部分

は、正孔翰送帯域として作用するので、第2図に示されるように、その正孔翰送効率に関して選ばれた有機物質の層205をアノード上に沈着させることによって形成するのが好ましい。正孔翰送層の上には、その電子翰送効率に関して選ばれた有機物質の層207を沈着させる。カソードストリップのあるものの部分209は有機電界発光媒体の電子輸送性の上層の上に載置せしめられる。

第3図は、本発明のもう1つの好ましい態様を示す単一のピクセル300を断面で示したものである。有機Eしデバイスの発展の歴史的パターンと対照的に、ピクセル300かである。デバイス300位のカソード309を介してである。デバイス300であることができ、それによってアノードおよびであることができ、それによってアノードおよびであるということが可能であるば、デバイス300に例えては、デバイス300に例えては、デバイス300に例えては、デバイス300に関数の金属のような不透明の電荷に導性材料を使用してアノードストリップ301を形成する。正孔および電子の輸送層305 および307

(15)

(16)

はデバイス200 の対応の暦205 および200 に同じ であることができる。デバイス200 と300 の間の 顕著な相違点は、後者は有機ELデバイスにおい て慣用的に含まれる不透明なカソードの代りに薄 い光透過性のカソードストリップを用いているこ とである。

ELデバイス200 および300 の有機電界発光媒体は単一の有機正孔注入及び輸送層と単一のでは入及び輸送層とからなると先に記載したけれるように、これらの層のそれである。以下に詳述するように努力した場合、デバイスの性能を一段と向上させることができる。多層の内部において正孔一電子の財政る層は、その層の内部において正孔一電子の財結合が行われかつそのためにデバイスの発光帯域を形成する層である。

本発明のマトリクスアドレス方式の有機ELデバイスを製作するため、便宜な順序の加工工程の 最初として、アノードのストリップを透明基板上 に形成する。多数の金属物質が透明又は不透明な アノード材料として有用であるけれども、この目 的のために好ましい透明なアノード材料の1種は 商樓 "ネサトロン(Nesatron)" として商業的に入 手可能である。この材料は、薄くて透明なインジ ウム錫酸化物(ITO) の層をガラス上に形成したも のである。透明な導電性層は、好ましくは、約 0.1~1.0 mの厚さを有している。 ガラスシート を所望の寸法に切断し、そして次に洗浄及び研磨 を行う。導電性層を狭くて平行なアノードストリ ップからなる所望のパターンに変形するが、この パターニングは常用のエッチング技法を用いて行 う。手法の一例を示すと、1)シートをジクロロ メタン中で清浄にし、2) 濱浄にした組成物にホ トレジスト組成物を塗布し、3)塗布の完了した シートを回転乾燥し、4)被膜を80℃で30分間に わたってペークし、5)被膜を所望のラインパタ ーンをもったマスクと接触させ、UV光に3秒間 にわたって露光し、そして6) 露光後の被膜を約 60秒間にわたって溶媒と接触させることによって 現像し、次にn-ヘプタンですすぎ、風乾する。

透明なアノードストリップを透明基板上に形成 した後、有機電界発光材料の薄膜をアノードスト リップの上に、好ましくは真空蒸着法を用いて、 被着させる。以下に詳しく述べるように、特定の 材料ではマトリクスアドレス方式のELデバイス と組み合わさった特別の長所が得られるけれども、 多種多様のかかる有機材料を使用することが可能 である。この有機材料は、一例を示すと、例えば 芳香族第3アミンのような正孔輸送化合物の第1 の層、そして例えばキレート化オキシノイド化合 物のような電子輸送化合物の第2の層(これが発 光帯域を構成する)を有する。これらの2つの層 を、嘉着法によって、加熱した石英ポートから被 着させることができる。次いで、この有機電界発 光材料の最上層の上にカソード材料の強くて均一 な層を被着させる。このカソードに適当な材料及 び膜厚は以下において詳細に記載する。

次いで、カソード層をパターニングしてアノードストリップの方向に対して垂直な方向に延在する狭いストリップを得るため、ホトリソグラフィ

(20)

ーを使用する。この目的のために、架構可能なホ

トレジストの組成物を連続した層の形でカソード

層上に塗布する。ホトレジスト組成物をカソード

層に適用する好ましい1方法はスピンコート法で ある。例えばナイフコート法のようなその他の方

法も使用可能であるが、基板に引掻き傷を入れな

いように注意することが肝要である。光開始剤と

混合して溶媒から塗布し、次いでUV光によって 重合及び架構させることができる特に有用な部類

に属する重合可能及び架構可能な単量体は、例え

ば、米国特許第 4.322.490号及び岡第 4.619.890 号に開示されている。特に有用なものは、米国特

許第 4.619.890号に開示されているベンセントリカルボン酸アルキルアクリル酸エステルである。

これらの単量体を、例えばアミン開始剤のような

光開始剤及び3ーケトクマリン増感剤と一緒に、

例えば2-エトキシエタノールエタノールのよう

な溶剤(B L デバイスの有機電界発光材料を溶解 しないもの)中で混合する。有用な光開始剤及び

溶剤の例は先に引用した米国特許のなかに開示さ

(19)

れている。

本発明のマトリクスアドレス方式の有機ELデ バイスは、その最も広い面において、ELデバイ スに適当である任意の有機電界発光材料と任意の 電極材料を使用することができる。本発明のデバ イスは、しかし、先に参照した好ましい材料の1 種類もしくはそれ以上を組み合わせてデバイスの 製作に用いた場合により大きな利点をもたらすこ とができる。すなわち、(a)発光物質を含有す る薄膜の発光帯域、(b)アノードと接触せる正 孔注入ポルフィリン系化合物を含有する層、およ び/または(c)低い仕事関数を有する最低1種 類の金属(アルカリ金属以外)を有するカソード。 発光帯域に蛍光物質が含まれないような場合には、 電界発光材料は、しかし、以下において蛍光物質 用のホスト物質として開示するようないろいろな 有機物質を任意に有することができる。

発光帯域に蛍光物質が含まれるような好ましい 態様において、前記発光帯域は薄膜であり(ここ で、"薄膜"なる語は、1 m未満の厚さをもった ものを指すために用いられる)、また、この薄膜は、正孔及び電子の注入を持続することが可能な有機ホスト物質、そして正孔一電子再結合に応答して光の放射が可能な蛍光物質を含有する。発光帯域は、その有機電界発光媒体全体が1 四未満、好ましくは1000人未満の厚さであることができるよう、50~5000人、最適には 100~1000人の範囲の厚さを保持するのが好ましい。

ホスト物質は、有機ELデバイスの薄膜発光帯域の活性成分として従来用いられる物質のどれからでも便宜に形成させることができる。薄膜の形成に使用するのに適するホスト物質の中にはジアリールブタジェンおよびスチルベンであり、またこれらの物質は先に引用のTangの米国特許4.356.429によって開示されているようなものである。

使用できるさらに他の薄膜形成ホスト物質は蛍光増白剤、特に上配引用の Van Slykeらの米菌特許第 4.539.507号によって開示されているものである。有用である蛍光増白剤は、次の構造式(I)又は(II)を満たすものを含み、

$$\begin{array}{c}
D^{1} \longrightarrow D^{3} \longrightarrow D^{5}
\end{array}$$
(II)

(23)

mは0から4の整数であり、

nは6個から10個の炭素原子のアリーレン基、 例えばフェニレンおよびナフチレンであり、そして

D・は水素;1個から10個の炭素原子を有する 飽和脂肪族置換基、例えばアルキル置換基;6個 から10個の炭素原子を有するアリール基、例えば フェニルまたはナフチル;あるいは、クロロまた はフルオロのようなハロ置換基であり、

D ⁷ は例えばフェニルまたはナフチルのような 6 個から10個の炭素原子を有するアリーレン基であり、

2′と2″は独立にNまたはCHである。
ここで用いるさとき、「脂肪族」とは置換された
脂肪族並びに非置換の脂肪族を含む。置換脂肪族
の場合の置換基は1個から5個の炭素原子を有す
るアルキル基、例えばメチル、エチル、プロピル
など;6個から10個の炭素原子を有するアリール
基、例えば、フェニルおよびナフチル:例えばクロロ、フルオロなどのようなハロゲン;ニトロ基;

D² は例えばメチル、エチル、ローエイコシルなどのような1個から20個の炭素原子を有する飽和脂肪族基;6個から10個の炭素原子を有するアリール基、例えばフェニルおよびナフチル;カルボキシル;水素;シアノ、あるいはハロゲン例えばクロロ、フルオロなどであり、ただし、式(I)において、D² , D⁴ およびD⁵ の少くとも2つは3個から10個の炭素原子を有する飽和脂肪族基、例えば、プロピル、ブチル、ヘブチルなどであり、

Z は - O - . - N (D $^{\bullet}$) - 、あるいは - S - であり、そして

Υは

$$-D^{7} + CE = CE + \frac{1}{n}D^{7} - \frac{1}{n} - \frac{1}{n} - CE = CE - \frac{1}{n} - CE - \frac{1}{n} - CE = CE - \frac{1}{n} - CE - \frac{1}{n} - CE - \frac{1}{n} - \frac{1}{$$

これらの式において、

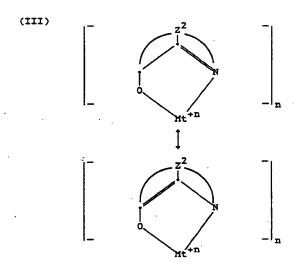
(24)

および 1 個から 5 個の炭素原子を有するアルコキシ基、例えばメトキシ、エトキシ、プロポキシなどを包含する。

有用であることが期待されるさらに他の蛍光増 白剤はChemistry of Synthetic Dyes, 1971, 618 -637ページおよび 640ページにおいて列挙されて いる。まだ薄膜形成性でないものの一端又は両端 の環に脂肪族成分を結合させることによってその ものを薄膜形成性にすることができる。

本発明の有機ELデバイスの発光帯域を形成するための特に好ましいホスト物質は金属キレート化オキシノイド化合物であり、オキシン(これはまた普通には8ーキノリノールあるいは8ーヒドロキシキノリンとよぶ)のキレートを包含する。このような化合物は両方とも高水準の性能を示し、薄膜の形に容易に加工可能である。推奨されるオキシノイド化合物の例は次の構造式(II)を満たすものである:

(25)



式中、Mt は金属を衷わし、

nは1から3の整数であり、

2°は各々の存在個所で独立に、少くとも2個の縮合芳香族環をもつ核を完成する原子を表わす。

(27)

属であり得ることが明らかである。かかる金属は、例えば、リチウム、ナトリウムまたはカリウムのようなアルカリ金属;マグネシウムまたはカルシウムのようなアルカリ土類金属;あるいは硼素またはアルミニウムのような土類金属であることが知られている1価、2価または3価の金属を任意に用いることができる。

2* は少くとも2個の総合等季旋槽を含む複要

前配から、金属は1価、2価、または3価の金

2 は少くとも2個の総合芳香族環を含む複素環を完成し、その中の一つはアゾール環またはアジン環がある。必要に応じて、脂肪族環および芳香族環の両方を含む追加の環を前配の二つの必要環と一緒に総合させることができる。作用の改善もなく分子の嵩が増大することを避けるために、環原子の数は18個またはそれ以下で保つのが好ましい。

薄膜を形成させるために使用可能である有用な ホスト物質の例としては次のようなものがある:

(28)

- BM-1 アルミニウムトリスオキシン (別名、トリス(8-キノリノール)ア ルミニウム)
- BH-2 マグネシウムピスオキシン 「別名、ピス(8-キノリノール)マグ ネシウム)
- HM-3 ピス [ベンゾ { f } -8-キノリノール] 亜鉛
- HM-4 ピス(2 メチルー 8 キノリノラート) アルミニウムオキサイド
- EM-5 インジウムトリスオキシン 〔別名、トリス(8-キノリノール)ィ ンジウム〕
- BM-6 アルミニウムトリス (5ーメチルオキシン) (別名、トリス (5ーメチルー8ーキノ リノール) アルミニウム)
- HM-7 リチウムオキシン 【別名、8-キノリノールリチウム】
- EM-8 ガリウムトリスオキシン 〔別名、トリス(5-クロロー8-キノ リノール)ガリウム〕
- BM-9 カルシウムピス(5-クロロオキシン) (別名、ピス(5-クロロー8-キノリ ノール)カルシウム)
- HM-10 ポリ (亜鉛 (II) ーピス (8 ーヒドロキ シー5 ーキノリニル) メタン i
- BM-11 ジリチウムエピンドリジオン
- HM-12 1 . 4 ジフェニルブタジエン

- HM-13 1,1,4,4ーテトラフェニルプタジ
- HM-14 4 , 4 ' ーピス (5 , 7 ージ (t ーペンチルー 2 ーベンズオキサゾリル) ースチルベン
- HM-15 2 . 5 ーピス (5 . 7 ージ (t ーペンチルー2 ーペンズオキサゾリル) ーチオフェン
- HM-16 2 . 2' (1 . 4 フェニレンジビニレン) ピスペンゾチアゾール
- HM-17 4 . 4′ (2 . 2′ ビスチアゾリル) ビフェニル
- BH-18 2 , 5-U \mathcal{A} ($5-(\alpha,\alpha-3)$ \mathcal{A} \mathcal{A}
- HM-20 トランススチルベン

上記列挙のホスト物質はすべて正孔および電子の注入に応答して光を放射することが知られている。正孔一電子再結合に応答して光を放射し得る 蛍光物質の少量をホスト物質と混合することにより、その発光帯域から放射される光の色相を変化 させることができる。理論上は、もしも正孔一電

(29)

子再結合に対して正確に同じ観和度をもつホスト 物質および蛍光物質を混合用に見出し得るとすれ ば、各物質は発光帯域中の正孔および電子の注入 時に光を放射するはずである。光放射の感知でき る色相は両方の放射を肉眼的に積算したものであ る。

4.5

本スに選とかって、 大物質とかもようで、光放度を定めて、 大物質をあるうには、光物質をあるうには、光物質をあるうには、光物質を表現にで、 大力をはまるがある。 大力をはまるがある。 大力をはまるがある。 大力をはまるがある。 大力をはまるがある。 大力をはまるがある。 大力をはまるがある。 大力をできるがある。 大力をできるがある。 大力をできるができるが、 大力である。 大力でもない。 大力ではない。 大力ではない。 大力でもない。 大力ではない。 大力でもない。 大力ではない。 大力でない。 大力でなない。 大力でなななななななななななななななな

光放射に好部合な部位を与えることができる単 光物質の選択は蛍光物質の性質をホスト物質は性 質と関係づけることを包含する。ホスト物質は足 入される正孔と電子のためのコレクタとして子 ことができ、蛍光物質は光放射のための分子部位 を提供する。ホスト物質中に存在する時に光 の色相を変化させることができる蛍光物質を選択 するための一つの重要な関係は、その二つの物質

(31)

(32)

の選元電位の比較である。光放射の波县をシフトさせることが示されている蛍光物質はホスト物質はホスト物質はホストで倒立ででいるが、文献中ではないで、選元電位を表されるが、文献中でいる。望まれるのは、絶対値ではなく選元電位でいる。望まれるのは、絶対値で用の許容される技法はどれても、蛍光物質とホスト物質の選元電位の両方が同じように測定される限り使用できることが明らかである。好ましい酸化還元電位測定の技法はR.J.Cox のPhotographic Sensitivity

(Academic Press、1973年、15章) によって報告されている。

ホスト物質中に存在するときに光放射の色相を変えることができる蛍光物質を選ぶための第二の重要な関係は、この二つの物質のバンドギャップ電位の比較である。分子のバンドギャップ電位とそ分離するエレクトロンボルト(eV)としての電位差としてみなされる。バンドギャップ電位とそれらの測定

法は文献中に広く報告されている。ここで報告されるパンドギャップ電位は、吸収ピークに対して最波長側へ偏移しており吸収とークの大きさの1/10の大きさのものである吸収波長においてエレクトロンボルト(eV)で測定したものである。 望まれるの地対値でなくパンドギャップがともに同様に測定される限り、許ギャップがともに同様に測定される限り、許されているの代例的な測定法はF. GutmanおよびL. B. LyonsによるOrganic Semiconductor (Wiley、1967年、5章)によって開示されている。

世光物質の不存在において自ら光を放射することができるホスト物質が選ばれる場合には光を合いる光をか質単独の特徴的な発光の波長においる光になる発光の抑制と世光物質について特徴的でおこことが観光においる発光の描述は、ホスト物質と世光物質とが表において特徴的である発光の波長とホスト物質のである発光の波長とホスト物質のである発光の波長とホスト物質のである発光の波長とホスト物質のである発光の波長とホスト物質のである発光の波長とホスト物質のである発光の波長とホスト物質のである発光の波長とかないでもないでは、

上述の説明は、正孔および電子の注入に応答して自ら光を放射することが知られているホスト物質に言及することによってなされてきたが、事実、ホスト物質自体による光放射は、蛍光物質による光放射が上記記述の各種の関係のどれか一つまたは組合せに好都合である場合に、完全に止むことができる。光放射の役割を蛍光物質へ転旋するこ

(35)

スト物質中での分子レベル分布に合致するからである。ホスト物質中に蛍光染料を分散させる、めの便利な技法は任意に使用し得るけれども、好ましい蛍光染料はホスト物質と一緒に蒸着させることができる染料である。先に配述したその他の規 単が満たされると仮定すると、蛍光レーザー染めが、本発明の有機ELデバイスで使用するための特に有用な蛍光物質であることが認められる。

蛍光染料の一つの好ましい部類は蛍光クマリン 染料である。特に好ましい蛍光クマリン染料の中 には次式(Ⅳ)を満たすものがある:

式中、

R' は水素、カルボキシ、アルカノイル、アル コキシカルボニル、シアノ、アリール、および複 とはホスト物質の選択のさらにより広い範囲を可能にすることが理解される。例えば、光を放射である。例えば、光を力選ばれる物質についての一つの基本的では、その物質が放射する波長の光についならなが、との数を示して内部的吸収を避けねばならまかである。本発明は、正孔および電子効果は、正孔およりはないのとに光を放射することができないホスト物質を使用することを可能とする。

有用である蛍光物質は、ホスト物質と混合する 蛍光物質は、ホスト物質と混合する 蛍光ができかつ本発明のBLデバイスの発光 を形成する上述の厚さ範囲を満足させる薄膜である。結晶質のホスト物質は自体薄膜形成に適合しないが、量は単独では で存在する 蛍光物質の限定された量は 単独では では 世界形成をなし 得ない 蛍光物質の使用を 可能に 共 は の相を形成する 物質である。 蛍光材料 は いまいか 歌類の蛍光物質を構成するが、それは、染料が か

(36)

素環芳香族の基から成る群から選ばれ、

R* は水素、アルキル、ハロアルキル、カルボ キシ、アルカノイル、およびアルコキシカルボニ ルから成る群から選ばれ、

R®は水素とアルキルから成る群から選ばれ、

R* はアミノ基であり、そして

R® は水素であり、

あるいは、R!とR!とは一緒になって縮合炭素 環を形成し、そして/または

R®を形成するアミノ基はR®およびR®の少くとも一つと一緒に縮合環を完成する。

各々の場合におけるアルキル成分は1個から5個、好ましくは1個から3個の炭素原子を含む。アリール成分は好ましくはフェニル基である。縮合炭素環状環は好ましくは五異環、六異環または上異環である。複素環式芳香族基は、炭素原子と、酸素、硫黄および窒素から成る群から選ばれる1個の複素原子とを有する五異または六異の複素環を含む。アミノ基は一級、二級、または三級のアミノ基であることができる。アミノ

(38)

案が隣接置換基と一緒に縮合環を完成するとき、 その環は好ましくは五員環または六員環である。 例えば、R⁵ は窒素原子が1個の隣接置換基(R³ またはR⁵)と単一環を形成するときにはピラン環 の形をとり、窒素原子が両隣接置換基R³ および R⁵ と一緒に環を形成するときにはジロリジン環 (クマリンの縮合ベンソ環を合む)の形をとるこ とができる。

以下はレーザー染料として有用であることが知られる蛍光クマリン染料の例である。

- FD-1 7ージメチルアミノー4ーメチルクマリン
- FD-2 4,6-ジメチルー7-エチルアミノクマリン
- FD-3 4ーメチルウムベリフェロン
- FD-4 3-(2'-ベンゾチアゾリル)-7-ジメチルアミノクマリン
- FD-5 3 (2' ペンズイミダゾリル) 7 - N , N - ジメチルアミノクマリン
- FD-6 7-アミノー3-フェニルクマリン
- FD-7 3 (2' N メチルベンズイミダゾリル) 7 N , N エチルアミノクマリン

(39)

- FD-20 9 アセチルー1 . 2 . 4 . 5 . 3 H . 6 H . 10 H テトラヒドロー (1) ベングピラノ (9 . 9 a . 1 g h) キノリジノー10 オン
- FD-21 9 シアノー1 . 2 . 4 . 5 . 3 H . 6 H . 10 H テトラヒドロ [1] ベンソビラノ [9 . 9 a . 1 g h] キノリジノー10 オン
- FD-22 9- (t-ブトキシカルボニル) 1 . 2 . 4 . 5 . 3 H . 6 H . 10 H テトラヒドロ (1] ベンゾピラノ (9 . 9 a . 1 g h) キノリジノ 10 オン
- FD-23 4-メチルピペリジノ〔3,2-g〕クマリン
- FD-24 4ートリフルオロメチルピペリジノ〔3. 2ーg〕クマリン
- FD-25 9 カルボキシー1 , 2 , 4 , 5 , 3 H 6 H , 10 H - テトラヒドロ [1] ベンゾ ピラノ [9 , 9 a , 1 - g h] - キノリ ジノー10-オン
- FD-26 N-エチルー4-トリフルオロメチルピペリジノー (3,2-g) クマリン

蛍光染料のもう一つの好ましい部類は蛍光性の 4 ージシアノメチレンー 4 H ーピランおよび 4 ー ジシアノメチレンー 4 H ーチオピラン (以後は蛍 光性ジシアノメチレンピラン染料および蛍光性ジ シアノメチレンチオピラン染料とよぶ)である。

- FD-8 7ージエチルアミノー 4 ートリフルオロメチルクマリン
- FD-9 2 . 3 . 5 . 6 1 H . 4 H テトラヒ ドロー 8 - メチルキノラジノ〔9 . 9 a 1 - g h〕クマリン
- FD-10 シクロベンタ (c) ジュロリジノ (9. 10-3) -11 H ピラン11 オン
- PD-11 7-アミノー4-メチルクマリン
- FD-12 7 ジメチルアミノシクロペンタ(c) クマリン
- FD-13 7-アミノー4ートリフルオロメチルクマリン
- FD-14 7 ージメチルアミノー 4 ートリフルオロ メチルクマリン
- FD-15 1 , 2 , 4 , 5 , 3 H , 6 H , 10 H ーテトラヒドロー8 ートリフルオローメチル(1)ペンゾピラノ〔9,9a,1-gh)-キノリジン-10-オン
- FD-16 4ーメチルー?ー (スルホメチルアミノ) クマリン・ナトリウム塩
- FD-17 7 ーエチルアミノー 6 ーメチルー4ート リフルオロメチルクマリン
- PD-18 7 ージメチルアミノー 4 ーメチルクマリ
- FD-19 1 . 2 . 4 . 5 . 3 H . 6 H . 10 H ーテトラヒドローカルベトキシ [1] ーペンゾピラノ [9 . 9 a , 1 g h] ーキノリジノー10ーオン

(40)

この部類の好ましい蛍光染料は次式 (V)を満た すものである:

(V)
$$nc$$
 cn $R^7 = 1$ I_{-R}

式中、Xは酸素または硫黄を表わし、

 R^* は 2-(4-r ミノスチリル) 基を扱わし、そして

R * は第二の R * 基、アルキル基、あるいはアリール基を表わす。

Xは最も便宜には酸素または硫黄を表わすけれ ども、より高い原子番号のカルコゲンは長液長移 行型ではあるが同様な応答を与えるはずであるこ とが認められる。アミノ基は一級、二級または三 級のアミノ基であることができる。一つの特に好 ましい形において、アミノ基はスチリルフェニル 環と一緒に少くとも一つの追加の縮合費を形成す

4 - (ジシアノメチレン) - 2 , 6 - (2 - (9 - ジュロリジル) - エテニル) - 4 H - ピラン

4 - (ジシアノメチレン) - 2 - メチル - 6 - (2 - (9 - ジュロリジル) エテ ニル) - 4 H - チオピラン

有用な蛍光染料はまた既知のポリメチン染料の

中から選ぶことができる。かかるポリメチン築料

に、シアニン、錯シアニン及びメロシアニン (す

なわち、三核、四核および多核のシアニン及びメ ロシアニン)、オキソノール、ヘミオキソノール、

スチリル、モノスチリル、およびストレプトシア

シアニン染料は、メチン結合によって結合され

た例えばアゾリウム核またはアジニウム核のような 2 個の塩基性の複素環状核を含む。このような

染料は、例えば、ピリジニウム、キノリニウム、

イソキノリニウム、オキサゾリウム、チアゾリウ

ム、セレナゾリウム、インダゾリウム、ピラゾリ ヴム、ピロリリウム、インドリウム、3H-イン

ドリウム、イミダゾリウム、オキサジアゾリウム、 チアジアゾリウム、ベンズオキサゾリウム、ベン

(44)

ることができる。例えば、スチリルフェニル環とアミノ基は一緒になってジェノ基はスチリルフェることができ、あるの資またはアミノ基はスチリルフェニル環と縮合した五員または六員の環を形成できる。R * を形成するアリール基は個の炭素原子を含む。R * を形成するアリール基である。R * とR * の両者がとしてエニル基である。R * とR * の両者がと一(4ーアミノスチリル)基を形成することができるが、しかし対称性化合物がより便宜に合成される。

以下は蛍光性ジシアノメチレンピラン染料と蛍 光性ジシアノメチレンチオピラン染料の例である:

D-27 4 - (ジシアノメチレン) - 2 - メチル - 6 - (p - ジメチル-アミノスチリル) - 4 H - ビラン

FD-28 4 - (ジシアノメチレン) - 2 - メチル - 6 - (2 - (9 - ジュロリジル) エテ ニル) - 4 H - ピラン

FD-29 4 - (ジシアノメチレン) - 2 - フェニル-6 - (2 - (9 - ジュロリジル) エテニル) - 4 H - ピラン

(43)

.

ゾチアゾリウム、ペンゾセレナゾリウム、ペンゾテルラゾリウム、ペンズイミダゾリウム、3 Hーまたは1 Hーベンゾインドリウム、ナフトオキサゾリウム、ナフトテアゾリウム、カルバゾリウム、フェナンスロチアゾリウム、およびアセナフトチアゾリウムの四級塩から誘導されるものである。

塩基性複素環核の例は次式(VI)と(VI)を満たすものである:

上式において、

FD-30

FD-31

ニンが含まれる。

Z ª は塩基性複素環式窒素化合物から誘導され る環状核を完成するのに必要とされる要素を表わ し、それらの窒素化合物は、例えば、オキサゾリ ン、オキサゾール、ベンズオキサゾール、ナフト オキサゾール類 (例えば、ナフトー (2,1-d) オキサゾール、ナフト〔2 ,3 - d〕オキサゾー ル、およびナフト(1,2-d)オキサゾール)、 オキサジアゾール、チアゾリン、チアゾール、ベ ンゾチアゾール、ナフトチアゾール類(例えば、 ナフト〔2,1-4〕チアゾール)、チアゾロキ ノリン類(例えば、チアゾロ〔4,5-b〕キノ リン)、フェナンスロチアゾール、アセナフトチ アゾール、チアジオキサゾール、セレナゾリン、 セレナゾール、ベンゾセレナゾール、ナフトセレ ナゾール類(例えば、ナフトー〔1,2 - d〕セ レナゾール)、ベンゾテルラゾール、ナフトテル ラゾール類 (例えば、ナフト [1,2-d] テル ラゾール)、イミダゾリン、イミダゾール、ベン ズイミダゾール、ナフトイミダゾール類(例えば、

(46)

(45)

ナフト〔2,3-d〕ィミダゾール、2-または 4-ピリジン、2-または4-キノリン、1-ま たは3-インキノリン、ペンゾキノリン、3 H-インドール、1H-または3H-ベンゾインドー ル、およびピラゾールのようなものであり;上記 の核はその環の上で広範な種類の置換基の一つま たは一つ以上によって置換されていてもよく、そ れらの置換基は、ヒドロキシ、ハロゲン類(例え ば、フルオロ、クロロ、プロモおよびヨード)、 アルキル基または置換アルキル基(例えば、メチ ル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、 オクチル、ドデシル、オクタデシル、2-ヒドロ キシエチル、3-スルフォプロピル、カルボキシ メチル、2-シアノエチル、およびトリフルオロ メチル)、アリール基または置換アリール基(例 えば、フェニル、1-ナフチル、2-ナフチル、 4-スルフォフェニル、3-カルボキシフェニル、 および4ーピフェニリル)、アラルキル基(例え ば、ベンジル及びフェネチル)、アルコキシ基 (例えば、メトキシ、エトキシおよびイソプロポ

キシ)、アリールオキシ基(例えば、フェノキシと1ーナフトキシ)、アルキルチオ基(例えば、 メチルチオおよびエチルチオ)、アリールチオ、 (例えば、フェニルチオ、pートリルチオ、シアナンジオキシ、シアノンジオキシ、シアノンジオキシ、シアノンジオキシ、シアナル、アミノ または 置換 アミノ 基 (例えば、アニリノ、ジメチルアミノ、 およびモルホリノ)、アシル基 (例えば、ホルミル、アセチル、ベンゾイル、およびベンゼンスルホニル)のようなものであり、

Q'は例えばピロール、インドール、カルバゾール、ベンズインドール、ピラゾール、インダゾール、およびピロロピリジンのような塩基性複素 環式窒素化合物から誘導される環状核を完成する のに必要とされる要素であり、

R は、置換基(例えば、カルボキシ、ヒドロキシ、スルホ、アルコキシ、スルファト、チオスルファト、ホスホノ、クロロ、およびプロモ置換基)をもつかあるいはもたない、アルキル基、アリール基、アルケニル基、あるいはアラルキル基を要

(47)

(48)

わし、

しは、その各々の場合において独立に、置換または非置換のメチン基、例えば一CR® 二基を衷わすように選ばれ、ここに、R® はメチン基が置換されていないときには水素を表わし、そして、メチン基が置換されているときには1個から4個の炭素原子を有するアルキルかあるいはフェニルを衷わすのが最も普通であり、そして

q は 0 または 1 である。

合する 5 個の 以 チン基を含むシアニン染料 (2 個の 塩基性 複素 染料 (2 個の 塩基性 複素 染料 技 を も な シアニン染料 (2 個の 塩基 性 複素 染料 純 な ち も な で ま た 、 後 電 式 枝 を も も り な で ま た な ま は な を ま な な ま な な ま な な ま な な ま な な ま な な ま な な か アニン 染料 は る る は 、 な ま な な か アニン 染料 は る る は な み ル ボ シアニン 染料 は 通 書 で む な よ ひ アニン 染料 は 通 書 で む な な か で ま な な は 通 都 行 性 吸 収 が 可 能 で も る ん 成 分 を 適 切 に 選 ぶ こ と か で き る 。

蛍光染料として使用するための好ましいポリメチン染料、特にシアニン染料はいわゆる不動化染料(rigidized dye) である。これらの染料は、一つの核がもう一つの核との関連で動くことが制約されるように構成される。このような制約は励起状態エネルギーの無放射性動的放散(radiationless, kinetic dissipation)を回避する。染料構造を不動化する一つの試みとして、独立した架構基を組

(49)

入れて、染料の末端核を結合するメチン額結合の ほかに別の結合を提供することがある。架橋ポリ メチン染料は、Brooker らの米国特許第2,478,367 号、Brooker の米国特許第2,479,152号、Gilbert の米国特許第4,490,463号、および、Tredwellら の"Picosecond Time Resolved Fluorescence Lifetimes of the Polymethine and Related Dyes"、 Chemical Physics, 43巻(1979年)、307-316 ベ ージ、によって解説されている。

ボリメチン染料核を結合するメチン額は、染料の末端塩基性核を結合する環状核の部分としてといて不動化させることによって不動化させることにはポリメチン染料、特定定的にはポリメチン染料、できる。一般的にはポリメチン染料、できることが合ったが、メチン結合の中にオキソ炭素架構性核は、大きなとである。オキソ炭素架構性核は、できる:

(51)

合の連結を示し、そしてもう一つの共鳴形において単結合の連結を示す。 どちらの共鳴形においても、核中の連結部位は各々の核の一部を形成するメチン基によって形成される。 ゼロメチンのポリメチン染料は黄色染料である。

酸性核の例は次式(IX)を満たすものである:

上式において、

G・はアルキル基または置換アルキル基、アリール基または置換アリール基、アラルキル基、アリールオキシ基、ヒドロキシ基、アミノ基、あるいは、置換アミノ基を表わし、ここで、代表的な置換基は式(VI)及び(VII)に関して先に記載した各種の形をとることができ;

G はG について列挙した基のどれか一つを 衷わし、さらに加えて、シアノ基、アルキルまた

式中、 口は 0 , 1 または 2 の整数である。

メロシアニン染料は、上述のシアニン染料タイプの塩基性複素環式核の一つを上述の、但しゼロ個、2個あるいはさらに多い偶数個のメチン基を含むメチン結合を介して酸性ケトメチレン核へ結合する。核間の結合にメチン基を含まないゼロメチンの染料は一つの共鳴形において核間で二重結

(52)

はアリールスルホニル基、あるいは - C - G ' に | C

よって表される基を表わすことができ、あるいは、 GºはGºと一緒にとるとき、次のような環状酸 性核を完成するのに必要とされる要素を表わす: 2,4ーオキサゾリジノン(例えば、3ーエチル -2,4-オキサゾリジンジオン)、2,4-チ アゾリジンジオン(例えば、3-メチルー2,4 ーチアゾリジンジオン)、2-チオー2,4-オ キサゾリジンジオン(例えば、3-フェニルー2 ーチオー2 , 4 ーオキサゾリジンジオン)、ロー ダニン、例えば3-エチルローダニン、3-フェ ニルローダニン、3-(3-ジメチルアミノプロ ピル)ローダニンおよび3ーカルボキシメチルロ ーダニン、ヒダントイン (例えば、1,3-ジェ チルヒダントインおよび3-エチル-1-フェニ ルヒダントイン)、2-チオヒダントイン(例え ば、1-エチル-3-フェニル-2-チオヒダン トイン、3-ヘプチル-1-フェニル-2-チオ ヒダントインおよびアリールスルホニルー2-チ

オヒダントイン)、2-ピラゾリン-5-オン、 例えば3ーメチルー1ーフェニルー2ーピラゾリ ンー5ーオン、3ーメチルー1ー(4ーカルポキ シブチル) -2-ピラゾリン-5-オンおよび3 ーメチルー2-(4-スルホフェニル)-2-ピ ラゾリンー5ーオン、2ーイソオキサゾリンー5 ーオン(例えば、3ーフェニルー2ーイソオキサ ゾリンー5ーオン)、3,5ーピラゾリジンジオ ン (例えば、1,2-ジエチルー3,5-ピラゾ リジンジオンおよび1,2-ジフェニル-3,5 - ピラゾリジンジオン)、1,3-インダンジオ ン、1,3-ジオキサンー4,6-ジオン、1, 3-シクロヘキサンジオン、パルピツル酸(備え ば、1-エチルパルビツル酸および1,3-ジェ チルパルピツル酸)、および、2ーチオパルピツ ル酸(例えば、1,3-ジエチルー2-チオパル ビツル酸および1,3~ピス(2-メトキシエチ ル)-2-チオパルピツル酸)、から誘導される ようなもの.

有用なヘミシアニン染料は上述のメロシアニン

(55)

有用なへミオキソノール染料は、式(IX)において示されるとおりのケトメチレン核、そして1個または1個より多くの奇数のメチン基を含む前述のメチン結合によって結合される式(X)において示されるとおりの核を示す。

有用なメロスチリル染料は、式(以)において示されるとおりのケトメチレン核、そして1個または1個より多くの奇数のメチン基を含む前述のメチン結合によって結合される次式(X I)において示されるとおりの核を示す:

この式において、

G³とG⁴は前配定義のとおりである。

前述のより長い波長のシアニン、メロシアニン、 へミシアニン、へミオキソノール、およびメロス チリル染料は、有用なより長波長のポリメチン染 料のより簡単な構造形態について例示しようとし 染料と本質的に同じであり、上式(IX)のケトメ チレン基の代りに次式(X)で示される基を置換 えることに違いがあるだけである。

ここに、

G^a とG⁴ は同じであっても異なっていて解説して式(VI)における環でルキル、アリール、置換アルキルを表なるではアルキルはアルキルを表でいない。 G^a と C^a と

(56)

たものである。一般的には、置換基が核とメチン 結合とを結合して追加の環状構造を形成すること ができることが認められる。その上、これらの塾 料は3個または3個より多くの核を含むことがです。 きる。例えば、メロシアニン染料をメチン連結に おいてシアニン染料タイプの第二の塩基性複素遺 状核で以て置換することによって、アロポーラー (allopolar) シアニン染料を形成させることがで きる。さらに、染料発色団の一部を形成していな い各種の置換基は希望に応じて変化させて染料の 物理的性質、特に疎水性および親水性を調整して、 用いられる特定の被膜形成成分に適合させること ができる。染料の脂肪族成分としてより多くの炭 素原子(例えば、約6個から20個の炭素原子)を もつ炭化水素基を選ぶことによって、それらの築 料をより親油性にすることができ、一方、より少 ない数の炭素原子(例えば1個から5個の炭素原 子)を含む炭化水素基および特に極性置換基をも つ炭化水素基を用いて染料をより観水性にするこ とができる。染料の芳香族成分は通常6個から10

(57)

個の炭素原子を含有する。

以下のものはより短かい波長 (< 550nm)におい て最大光吸収を行なうことができるポリメチン染 料の典型例である:

PTS=P-トルエンスルホネート

(59)

FD-37

FD-38

FD-39

FD-40

FD-41

(60)

FD-43.

FD-44 FD-45 FD-46

FD-48 FD-49 FD-50 FD-51

- FD-52
- FD-53
- FD-54
- FD-55
- FD-56

(62)

C1

FD-67 5 . 5 ' , 6 . 6 ' ーテトラクロロー 1 1 . ーエタンジイルー 3 . 3 ' . 8 ートリメチルベンズイミダゾロシアニン<u>P</u>トルエンスルホネート

多くのポリメチン染料はより長い可視波長(>550nm)における最大光吸収が可能であり、また、 最大蛍光波長は一般的にはスペクトルの赤および 近赤外部の中にある。以下のものはより長い可視 波長における最大光吸収が可能であるポリメチン 染料の典型例である:

(63)

FD-72

(64)

	R	نــ	R ^B	R	<u>-</u>	_x_	_
FD-76	-C4H9	-	H	_	-	C1 ⁻	
FD-77	-C ₁₈ ±37		Ħ		-	PTS	-
FD-78	-C4H9	-	CH ³	·—	-	C1	
FD-79	-C5H11		CH3			C1 ⁻	
FD-80	-i-C3E7	-	CH3		•	C1	
FD-81	-c3H2		C2H2	_		C1 ⁻	
FD-82	-C2H2		C2H2		٠.	C ₃ F ₇ CC	00
FD-83	-С ₂ н ₅		6H11	←CH=	CE72	cí-	
			コヘキシル		2		
FD-84	С ₂ Н ₅		15 ^H 31		CE72	C1 ⁻	
	R.F.	N 	R ^{8b}	d Rea	S N I R	R ^f	
	R	R ^{8a}	_R8b	RBc	RBd	_R ^f _	_x_
FD-85	-CH ₂ CH ₃	H	E	H	Ħ	Ħ	C1
FD-86	-CH2CH3	H	Ħ	Ħ	H	-0CH3	PTS
FD-87	-CH2CH3	Ħ	Ħ	Ħ	-CH3	H	C104
FD-88	-сн ₂ сн ₃	Ħ	CH ₂ -C-	 -CH ₂	Ħ	. н	C10 ₄

(65)

(67)

(69)

蛍光染料のもう一つの有用な部類は 4 − オキソー 4 H − ベンズー〔d , e〕アントラセン(以後・はオキソベンズアントラセン染料とよぶ)である。好ましい蛍光オキソベンズアントラセン染料は次式(XII)によって表されるものである。

のアルコキシカルボニルであり、さらに好ましく は、置換または非置換のアルコキシカルボニルで ある。

Wは水素であるかあるいは電子引抜又は求引基 であり、また、この語の意味は当業界において理 解されているとおりである(すなわち、極遠的手 順によって決定した場合に正のハメットのシグマ 値を一般的にもつ基)。特に有用である電子引抜 基は、限定されるものではないが、ハロ(例えば フルオロ、クロロ、ブロモ)、シアノ、カルボキ シ、アシル、置換または非置換のアリールスルホ ニル(好ましくは6個から10個の炭素原子のもの、 例えば、フェニルスルホニル、トリルスルホニル など)、置換または非置換のアルキルスルホニル (好ましくは1個から6個の炭素原子のもの、例 えばメチルスルホニル、エチルスルホニルなど)、 置換または非置換のジアルキルホスフィニル (好 ましくは、各アルキル基が独立に1個から10個の 炭素原子をもつもの、例えば、メチル、エチル、 ブチル、デシルなど)、および、置換または非置

(72)

換のジアルキルホスホノ(好ましくは、各アルキル基が独立に上記定義のとおり1個から10個の炭素原子をもつもの)を含む。好ましくは、Wは水素またはハロゲンである。

Y'は水素であるか、あるいは不対電子または カチオンが組み合わさった負の電荷をもつヘテロ 原子から成る基、例えば、ヒドロキシ、メルカブ トあるいはアミノ (-NR" R"") である。 R " お よび R " は独立に置換または非置換のアルキル (好ましくは1個から10個の炭素のもので、例え ばメチル、エチル、デシルなど)、置換または非 置換のアリール(好ましくは6個から10個の炭素 のものであり、例えばフェニル、ナフチルなど) であり、あるいは、R"とR"とは、一緒に組み 合わさった時、置換または非置換の複素環式理 (好ましくは5個から10個の炭素原子、窒素原子 または酸素原子のもので、例えばモルホリノ、ピ ロリジニル、ピリジル、ピペリジノなどの環)を 完成するのに必要な原子を衷わすことができる。 Y'はまた置換または非置換のアルコキシ(好ま

しくは1個から10個の炭素原子のもので、例えば メトキシ、エトキシ、2 - クロロー1 - プロポキ シなど)、置換または非置換のカルバミルオキシ

0

(-O-C-NR"R")(式中、R"とR"は上記 定義のもの)、-O-M・あるいは-S-M・(式中、 M・は1価のカチオン、例えばNa・, K・, Li・, NH4・など)であることができる。好ましくは、 Y・はヒドロキシあるいは-O-M・である。

	<u>R•</u>	<u>w</u>	<u> Y'</u>
FD-114	メチル	水素	ヒドロキシ
FD-115	メチル	水素	- 0-Na-
FD-116	メチル	クロロ	ヒドロキシ
FD-117	メチル	クロロ	- 0-Na.
FD-118	メチル	900	N - メチルー N - フェニル カルバミルオ キシ
PD-119	メチル	水素	ピロリジニル
FD-120	ブトキシカルボニル	水素	ヒドロキシ
FD-121	プトキシカルボニル	水素	— 0-Na+
FD-122	プトキシカルポニル	クロロ	— 0- N a •

(75)

染料である。キサンテン染料の一つの特に好まし い部類はローダミン染料である。好ましい蛍光ロ

- ダミン染料は次式(XII)によって示されるも

のである:

(XIII)

この式において、

上記で例示したオキソベンズアントラセン染料は、置換基がその化合物の蛍光に悪い影響を及ぼさないかぎり、構造式中で特に例示したもの以外に、アルキル(例えば、1個から5個の炭素原子のアルキル)、アリール(例えばフェニル)およびその他の基のような、1個または1個より多くの置換基をもつことができる。

オキソベンズアントラセン染料は一般的には次の手順を用いて調製することができる。いくつかの製法の詳細は以下に記載する。一般的な製造手順は、(1)Cooke らのAustrallian J. Chem.・11・230-235 ページ(1958年)によって記述されている手順によるジヒドロフェナレノンの調製、(2)ジヒドロフェナレノンのリチウムエノレートと適切なホスホニウム・ヨーダイド反応剤との反応、および(4)この生成物を塩化第二銅およびリチウムクロライドと反応させて塩素化または非塩素化染料を生成させること、を含んでいる。

蛍光染料のもう一つの有用な部類はキサンテン

(76)

R'*とR''は独立に、水素、カルボキシル、スルホニル、アルカノイル、あるいはアルコキシカルボニル基であり、

R¹⁸, R¹⁸, R¹⁴およびR¹⁸は水素であり、 R¹⁴, R¹⁷, R¹⁸およびR¹⁹はアルキル基であ り、そして

X はアニオンであり、あるいは 次の置換基対:R ^{1 *} とR ^{1 *}、R ^{1 *} とR ^{1 *}、R ^{1 *} と R ^{1 *}、およびR ^{1 *} とR ^{1 *} のどれか一つまたは全部 は単独へテロ原子として窒素を含有する五員環ま たは六員環を完成する。

アルキル成分は、各々の場合において、1個から5個の炭素原子、好ましくは1個から3個の炭素原子を含有する。置換基対が縮合環を完成する時には、その縮合環は例えば、式の窒素原子を含む単一の縮合環が形成されるときにはビランの形を、あるいは、式の同じ窒素原子を各々が含む2個の縮合環が形成される時には、ジュロリデン環(式の縮合ベング環を含む)の形を、取ることができる。

(78)

以下のものは有用なレーザー染料であることが 知られているローダミン染料の典型例である:

FD-123 【9-(o-カルボキシフェニル)-6 -(ジエチルアミノ)-3H-キサンテン-3-イリデン】ジエチルアンモニウムクロライド 【別名、ローグミンB】

FD-124 N- (6- (ジエチルアミノ) - 9- (2-エトキシカルボニル) - フェニル) - 3 H - キサンテン- 3 - イリデン) - N- エチルエタンアミニウムパークロレート

FD-125 エチル<u>o</u>ー (6 - (エチルアミノ) - 3 - (エチルイミノ) - 2 . 7 -ジメチル - 3 H - キサンテニル) ベンゾエートク ロライド

FD-126 エチル<u>o</u>ー(6-(エチルアミノ)-3 -(エチルイミノ)-2 . 7 -ジメチル - 3 H-キサンテニル)ベンゾエートパ -クロレート

FD-127 エチル<u>o</u>ー〔6ー(エチルアミノ)-3 -(エチルイミノ)-2 . 7 ージメチル -3 H -キサンテニル〕ペンゾエートテ トラフルオロボレート

FD-128 <u>o</u>ー (6 - (エチルアミノ) - 3 - (エチルイミノ) - 2 . 7 - ジメチルー 3 H - キサンテニル) 安息番酸

FD-129 <u>o</u>ー(6-アミノー3-イミノー3H-キサンテニル)安息香酸・ハイドロクロ ライド

(79)

ここに、

R¹*とR¹¹は前記定義のとおりであり、

R^{**} とR^{**} は水素、アルキル、アリール、あるいはハロゲン置換基である。好ましいアルキル基は1個から5個、最適には1個から3個の炭素原子を含有し、一方、フェニルは好ましいアリール基である。

代表的フルオレセイン染料は、

FD-119 9- (<u>o</u>-カルボキシフェニル) - 6-ヒドロキシー3H-キサンテン-3-ォ

FD-120 9-(o-カルボキシフェニル)-2, 7-ジクロロー6-ヒドロキシー3H-キサンテン-3-オン

である.

蛍光染料のもう一つの有用なグループはピリリウム、チアピリリウム、セレナピリリウム、およびテルロピリリウム染料である。これらの部類のうちのはじめの三つの染料は Lightの米国特許第3.615.414号によって開示されており、後者の部類の染料は Dettyの米国特許第4.584,258号によって開示されている。後者の二つの部類の染料は

FD-130 <u>o</u>ー(6 ー(メチルアミノ)-3 ー(メ チルイミノ)-3 H -キサンテン- 9 -イル)安息香酸パークロレート

FD-131 メチル<u>。</u>- (6-アミノ-3'-イミノ - 3 H-キサンテン-9-イル) ベンゾ エート・モノハイドロクロライド

FD-132 8 - (2、4 - ジスルホフェニル) - 2 3、5、6、11、12、14、15-1 H、 4 H・10H・13H-オクタヒドロキノリ ジノールー(9、9a、1-bc;9、 9a、1-hi)キサンチリウムヒドロ オキサイド内部塩

FD-133 スルフォローダミンB

FD-134 <u>o</u>ー〔6 ー(ジメチルアミノ)-3-(ジメチルイミノ)-3H-キサンテン -9-イル)安息香酸パークロレート

キサンテン染料のもう一つの特に好ましい部類はフルオレセイン染料である。好ましいフルオレセイン染料は次式 (XIV) によって表現されるものである:

(XIV)

(80)

赤外の方へ深色効果でシフトするので、前二者の 部類の染料が可視光放射の達成にとっては有利で ある。

代表的な好ましいピリリウム染料およびチアピ リリウム染料は次式(XV)によって表わされる:

(XV)

式中、R^{**}は水素、メチル、あるいは三級アミノ 基、最適には-NR^{**}R^{**}基であり、

R^{zz}はアルキル基であり、

X- はアニオンであり、

Jは酸素または硫黄である。

アルキル基は好ましくは1個から5個の炭素原子、 最適には1個から3個の炭素原子を含有する。式 (XV)を満たす代衷的なピリリウムおよびチア

(82)

to bergin, to, the angles in a 👠

ピリリウム蛍光染料は次のものである:

PD-135 4 - (4 - ジメチルアミノフェニル) - 2 - (4 - メトキシフェニル) - 6 - フェニルピリリウム・パークロレート

FD-136 4 , 6 - ジフェニル - 2 - (4 - エトキ シフェニル) - チアピリリウム<u>ア</u>ートル エンスルホネート

FD-137 2 - (4-メトキシフェニル) - 6 - フェニルー4 - (p-トリル) - ピリリウム・テトラフルオロボレート

蛍光染料のもう一つの有用な部類は蛍光カルボスチリル染料である。これらの染料は2-キノリノール環またはイソキノリノール環を特徴とし、しばしば他の環と縮合される。最大蛍光の液長は一般的には他の縮合環の存在とともに増大する。スペクトルの青色部分において蛍光を出す単純なカルボスチリル染料の代表的なものは次のものである:

FD-138 7-アミノー4-メチルー2-キノリノ ール〔別名、7-アミノー4-メチルカ ルポスチリル〕

FD-139 7 - ジメチルアミノー2 - ヒドロキシー 4 - メチルキノリン [別名、7 - ジメチ アミノー4 - メチルカルボスチリル]

FD-140 3,3'-ピス [N-フェニルイソキノ リン]

(83)

年 7 月 7 日公開)、によって開示されるものがある。一つの好ましいペリレン染料は次式 (X VI) によって表される:

$$(R^{24})_{3}$$

$$(R^{25})_{3}$$

ここに、

R^{*4}とR^{*8}はアルキル、ハロおよびハロアルキル置換基から成る群から独立に選ばれる。好ましいアルキル基は1個から5個の炭素原子、最適には1個から3個の炭素原子を含有する。

ペリレン染料のもう一つの好ましいグループは、3、4、9、10ーペリレンピス(ジカルボキシィミド)(以後はペリレンピス(ジカルボキシィミド)染料とよぶ)である。この部類の好ましい染料は次式(X W)によって表される:

より複雑な紹合環カルボスチリル染料の例は、
KadhimおよびPeters, "New Intermediates and
Dyes for Synthetic Polymer Fibers Substituted
Benzimidazolothioxanthenoisoquinolines for
Polyester Fibers", JSDC、1974年6月、199-201
ページ、とArientら、"Imidazole Naphthocxylenebenzimidazole Derivatives", JSDC、1968年6月、
246-251ページ、とによって与えられている。これらのより複雑なカルボスチリル染料の例は次のものである:

FB-141 ベンズイミダゾ(1 . 2 - b) チオキサンデノー(2 . 1 . 9 . d . e . f) ーイソキノリンズイミダゾ(1 . 2 - a) チオキサンズイミダゾ(1 . 2 - a) チオキサンナノリン - 7 - オン f) イソキノリン - 7 - オン

他の縮合環蛍光染料の中には、ジナフチレン核を特徴とするペリレン染料がある。種々の有用な蛍光ペリレン染料が知られており、例えば、Rade-macherら、"Soluble Perylene Fluorescent Byes with Photostability", 115巻, 2927-2934, 1982年、および、欧州特許出願第 553,353A1号 (1982)

(84)

ここに、

R[™]とR[™]はアルキル、ハロおよびハロアルキル置換基から成る群から独立に選ばれる。好ましいアルキル基は1個から5個の炭素原子、最適には1個から3個の炭素原子を含有する。

好ましいペリレン染料の例は次のものである: FD-142 ペリレン

FD-143 1 , 2 - ピス (5 , 6 - <u>o</u> - フェニレン ナフタレン)

FD-144 N,N′-ジフェニル-3,4,9,10 -ペリレンピス-(ジカルボキシイミド)

FD-145 N . N' - ジ (p - トリル) - 3 . 4 . 9 . 10 - ベリレンピス - (ジカルボキシィミド)

FD-146 N , N' -ジ(2,6-ジ-<u>t</u>ープチル) - 3 . 4 . 9 . 10 - ペリレンビス(ジカ ルボキシイミド)

ホスト物質との組合せにおいて有用である好ま

(86)

Commence of the second

しい染料を以上に長々と列挙したけれども、これらの列挙は特に同定される部類とさらに他の染料の部類との両方における既知蛍光染料の単なる例示にすぎないことを理解されたい。例えば、多くの他の部類の、アクリジン染料;ピス(スチリル)ベンゼン染料;ピレン染料;オキサジン染料;および屋々 POPOP染料とよばれるフェニレンオキサイド染料のような既知の蛍光染料が有用であり、これらの部類からの有用な染料を特に示すと次の通りである:

FD-147 9-アミノアクリジンハイドロクロライド

FD-148 <u>p</u>-ピス(<u>o</u>メチルスチリル)ベンゼン

FD-149 2 , 2 ' - p - フェニレンピス (4 - メ チルー 5 - フェニルオキサゾール

FD-150 5 , 9 - ジアミノベンゾ (a) フェノキ サゾニウムパークロレート

FD-151 5 - アミノー 9 - ジェチルアミノベンズ (a) フェノキサゾニウムバークロレー

FD-152 3 , 7 - ピス (ジエチルアミノ) フェノ キサゾニウムパークロレート

FD-153 3 , 7 ーピス (エチルアミノ) ー 2 , 8 ージメチルフェノキサジンー 5 ーイウム パークロレート

(87)

放射最大を示し、そして、同様に、スペクトルの 赤色部分において吸収最大をもつ染料はスペクト ルの近赤外部において放射最大を示す傾向がある。

本発明のELデバイスの有機電界発光媒体は、 少くとも二つの独立した有機質層を含有する。こ のような層の少くとも一つの層はカソードから注 入される電子を輸送するための帯域を形成し、そ して少くとも一つの層はアノードから注入される FD-154 9-エチルアミノ-5-エチルイミノ-10-メチル-5H-ベンゾ (a) フェノ

FD-155 8-ヒドロキシー1,3,6-ピレンートリスルフォン酸三ナトリウム塩

多くの入手可能な部類の蛍光染料の選択が可能であるだけでなく、与えられた部類内でも、個々の染料の性質について広い選択幅がある。個々の染料の吸収最大と還元電位は置換基の選択を通じて変えることができる。染料の発色団を形成する共役部分が増すにつれて、染料の吸収最大は深色効果により長波長側へシフトすることができる。

放射最大は吸収最大に対して深色効果を有する。この深色効果によるシフトの度合は染料の部類の関数として変動し得るけれども、通常は最大放射の波長は最大吸収の波長と比べて25から 125 mm 深色的にシフトせしめられる。したがって、近紫外において吸収最大を示す染料はほとんどすべて最大な射を示す。スペクトルの青色部分において収収最大を示す染料はスペクトルの緑色部分において

(88)

正孔を輸送するための帯域を形成する。先に引用 した Van Slykeらの米国特許第 4,720.432号に特 に詳しく数示されているように、後者の帯域はま た好ましくは少くとも二つの層で形成される。一・」 つの層はアノードと接触していて正孔注入帯域を 提供する。もう一つの層は、正孔注入帯域と電子 輸送帯域の間におかれて正孔輸送帯域を提供する。 本発明によるマトリクスアドレス方式有機ELデ バイスの好ましい態様は、 Van Slykeらによって 数示されるように少くとも三つの別々の有機層を 用いるが、正孔注入帯域を形成する層または正孔 輸送帯域を形成する層のどちらか一方を省略する ことができ、残りの層が両者の機能を果たすこと ができるであろうと考えられる。本発明の有機 ELデバイスのより高い初期および持続性能水準 は、以下に述べる別々の正孔注入層と正孔輸送層 とを組合せて用いる場合に実現される。

ポリフィリン系化合物を含む層は好ましくは本 発明のマトリクスアドレス有機ELデバイスの正 孔注入帯域を形成する。ポリフィリン系化合物は 天然または合成の任意の化合物であり、ポルフィン自身を含めて、ポルフィン構造から誘導されるかそれを包含する。 Adlerの米国特許第3,935,031 号またはTangの米国特許第4,356,429号によって開示されるポルフィリン系化合物を任意に使用することができる。

好ましいポルフィリン系化合物は次の構造式 (X幅)の化合物である:

ここに、Qは-N=または-C(R)=であり、 Mは金属、金属酸化物、あるいはハロゲン化金

(91)

有用なポルフィリン系化合物の高度に好ましい例は無金属フタロシアニンおよび金属含有フタロシアニンである。一般的にはポルフィリン なる金属を含むことができるが、その金属は好ましくは2もしくはそれより大きい正の原子価をもつ。好ましい金属の例は、コバルト、マグネシウム、亜鉛、パラジウム、ニッケルであり、そして特に銅、鉛および白金である。

有用なポルフィリン系化合物の典型例は次のも

属であり、

R は水素、アルキル、アラルキル、アリールあるいはアルカリールであり、そして

T! およびT* は水素を裹わすか、あるいは、 一緒に組み合わさって不飽和六員環を完成し、また該六員環は例えばアルキルまたはハロゲンのような置換基を含むことができる。好ましい六員環は炭素、硫黄および窒素の環原子で形成されるものである。好ましいアルキル成分は1個から6個の炭素原子を含み、一方、フェニルは好ましいアリール成分を構成する。

代りの好ましい形において、ボルフィリン化合物は、次式(IXX)によって示されるとおり、金属原子を2個の水素で置換した点によって前記構造式(XMI)の化合物と異なる。

(92)

のである:

PC-1 ポルフィン

PC-2 1 , 10 , 13 , 20ーテトラフェニルー21 H , 23 H ーポルフィンー鋼(II)

PC-3 1 . 10 , 15 . 20 — テトラフェニル — 21 H 23 H — ポルフィン亜鉛(Ⅱ)

PC-4 5 , 10 , 15 , 20 - テトラキス (ペンタフルオロフェニル) - 21 H , 23 H - ポルフ

PC-5 シリコン・フタロシアニンオキサイド

PC-6 アルミニウム・フタロシアニンクロライ ド

PC-7 フタロシアニン(無金属)

PC-8 ジリチウムフタロシアニン

PC-9 鰤テトラメチルフタロシアニン

PC-10 鋼フタロシアニン

PC-11 クロムフタロシアニンフルオライド

PC-12 亜鉛フタロシアニン

PC-13 鉛フタロシアニン

PC-14 チタンフタロシアニンオキサイド

PC-15 マグネシウムフタロシアニン

PC-16 鋼オクタメチルフタロシアニン

(93)

(94)

有機BLデバイスの正孔輸送層は少くとも一つの正孔輸送方香族第3アミンを含み、また、この場合、後者は、少くとも一つが方香族環の一員である炭素原子へ合む化合物であると理解とはモノアリールアミンにはポリマー状アリールアミンにはポリマー状アリールアミンの例は Klupfelらの米国特許第3、180、730 号によって解脱されている。ピニルをまたはピニレン基で以て置換されている。ピニルをまたはピニレン基で以て置換されている。ピニルをまたはピニレンをで以て置換されている。ピニルをまたはピニレンをで以て置換されている。ピニルをまたはピニーカアミンはBrantleyらの米国特許第3、567、450 号および同第3、658、520号によって開示されている。

芳香族第3アミンの好ましい部類は少くとも2個の芳香族第3アミン成分を含むものである。このような化合物は次の構造式(XX)によって表わされるものを含み、

(95)

あるいはアルキル基を衷わすか、R*4とR*5は一緒になって環状アルキル基を完成する原子を衷わし、

R^{*}*とR^{*}*は各々独立にアリール基を衷わし、 そしてこのアリール基はさらに次の構造式(XXII) によって示されるとおりジアリール置換アミノ基 で以て置換されており、

ここに、R^{z®}とR^{z®}は独立に選ばれるアリール基 である。

芳香族第3アミンのもう一つの好ましい部類はテトラアリールジアミンである。好ましいテトラジアリールジアミンは、アリーレン基を通して連結される、例えば前式(XXII)によって示されるような2個のジアリールアミノ基を含む。好ましいテトラアリールジアミンは次式(XXIII)によって表わされるものを包含する:

$$Q_{C}^{1}$$

ここに、 Q^{+} と Q^{*} は独立に芳香族第 3 アミン成分であり、そして

Gは例えばアリーレン、シクロアルキレンあるいはアルキレン基のような結合基、あるいは炭素・炭素結合である。

前記構造式(XX)を満たしかつ2個のトリアリールアミン成分を含むトリアリールアミンの特に好ましい部類は次の構造式(XXI)を満たすものである:

(XXI)
$$R^{24}$$
 $R^{27} \stackrel{|}{\underset{126}{}} - R^{25}$

ここに、

R²⁴とR²⁵は各々独立に水素原子、アリール基、

(96)

ここに、Araはアリーレン基であり、

nは1から4の整数であり、そして

A., R³⁰, R³¹およびR³²は独立に選ばれる アリール基である。

前記構造式(XX)、(XXI)、(XXI)、および
(XXII)の各種のアルキル、アリールおよびアリ
ーレン成分は各々さらに置換基を含有することルンと
できる。代表的な置換基は、アルキル基、アルナシ基、アリールオキシ基、アリールオキシスプアルカライドおよびアルキーシーでは通常約1個の対象原子を含むことができる。
の対し、通常5個、6個または7個の環境素のテンシのに、シクロペンチル、シクロペンチル、シクロペンチル、シ

クロヘキシルおよびシクロヘブチルの環構遺を含 むことができる。アリール成分およびアリーレン 成分は好ましくはフェニル成分およびフェニレン 成分である。

有機電界発光媒体の正孔輸送層の全体を単一の 芳香族第3アミンから形成することができるが、 安定性の増大は芳香族第3アミンの組合せを使用 することによって実現することができるというこ とが、本発明のさらに一つの認識である。とりわ け、例えば式(XXI)を満たすトリアリールアミ ンのようなトリアリールアミンを例えば式(XXII) によって示されるようなテトラアリールジアミン と組合せて用いることが有利であり得ることが観 寒された。トリアリールアミンをテトラアリール アミンと組合せて用いる時、後者はトリアリール アミンと電子注入及び輸送層の間に挿入される層 として配置される。

代表的な有用な芳香族第3アミンは Berwickら の米国特許第 4,175,960号および Van Slykeらの 米国特許第 4,539,507号によって開示されている。

(99)

常用の電子注入及び輸送化合物のどれでもカソ ードと隣接する有機電界発光媒体の層を形成する | 震に用いることができる。この層は、例えばアン トラセン、ナフタレン、フェナンスレン、ピレン、 クリセンおよびペリレン、並びに、例えばGurnee らの米国特許第 3.172,862号、Gurneeの米国特許 第 3.173,050号、Dresner, *Double Injection Electroluminescence in Anthracene". RCA Review. 30巻、 322-334ページ、1969年、および、先に引 用の Dresnerの米国特許第 3.710.167号によって 例示されているような約8個までの縮合環を含む その他の縮合環発光物質のような歴史的に数示さ れている発光物質によって形成することができる。 このような縮合環電界発光物質は自体薄膜(<1 m)の形成に適合せず、従って最高で到達し得る ELデバイスの性能水準の達成に不向きであるけ れども、かかる電界発光物質を超入れた、有機 ELデバイスは、それを本発明に従って構成する 時、従来のELデバイスと比べて性能と安定性に おいて改 を示す。

Berwickらはさらに、有用な正孔輪送化合物とし て、上記開示のジアリールアミンおよびトリアリ ールアミンの理架構変積と見ることができる積々 のN-置換カルパゾールを開示している。

有用な芳香族第3アミンの例は次のものである:

- , 1 ピス (4 ジー<u>ゥ</u> トリルアミフェニル) シクロヘキサン ATA-1
- 1.1-ビス(4-ジ-<u>p</u>-トリルアミ ノフェニル)-4-フェニル-シクロへ キサン ATA-2
- , 4′ーピス(ジフェニルアミノ)クードリフェニル ATA-3
- ス (4 ジメチルアミノー 2 メチル ュニル) フェニルメタン ATA-4
- ATA-5 N , N , N - トリ (<u>ァ</u>ートリル) アミン
- 4 (ジー<u>p</u>ートリルアミノ) 4′ -(4 (ジー<u>p</u>ートリルアミノ) スチリ ル)スチルベン ATA-6
- N, N, N', N' ーテトラー<u>p</u>ートリルー4: 4'ージアミノピフェニル ATA-7
- N , N , N' , N' テトラフェニルー 4 . 4' ジアミノビフェニル ATA-8
- N-フェニルカルパゾール ATA-9
- ポリ (Nーピニルカルパゾール) ATA-10

(100)

本発明のマトリクスアドレス方式の有機ELデ バイスにおいて、有機電界発光媒体の合計の厚み を1 m(10000オングストローム) 未満に制限する ことによって、電極間で比較的低い電圧を用いな、 がら、有効な光放射に対応する電流密度を保つこ とが可能である。 1 畑未満の厚さにおいて、20ポ ルトの印加電圧は2×10° ポルト/cmよりも大き い電界電位をもたらし、これは有効な光放射に対 応する。有機電界発光媒体の厚さの大きさの低減 の程度(0.1 皿または1000オングストロームへ) は、印加電圧をさらに減らし、そして/あるいは 世界電位を増やし、従って電流密度を増やすが、 デバイス構成の可能性の範囲内に十分に含まれる。

有機電界発光媒体が果たす一つの機能は、絶縁 性障壁(パリヤ)を提供して、ELデバイスの電 気的パイアス印加時において電極の短絡を防ぐこ とである。有機電界発光媒体を貫通して延在する 単一のピンホールすらも短絡をおこさせるであろ う。三つの重量せる有機層の存在が、配列されて いる層におけるピンホール存在の概会を大いに減 らして、電極間の連続伝導路を提供する。これは、 それ自体、被理時のフィルム形成にとって理想的 には適していない物質で以って有機電界発光媒体 の層の一つ、さらには二つを形成することを可能 ならしめ、一方では、許容できるBLデバイス性 能および信頼性もまた達成させるものである。

有機電界発光媒体を形成するのに好ましい物質は各々薄膜の形で製作でき、すなわち、0.5 maまたは5000オングストローム未満の厚さをもつ連続層として成膜できる。

有機電界発光媒体の層の一つもしくはそれ以上結を溶剤整布するとき、フィルム形成性ポリマーを溶剤を活性物質と一緒に同時被着させて、例えつは高いホールのような構造の欠陥をもたないのがである。結合はいのである。はいかくとも約2×10°が過去しない。適当で加水リマーは広範囲の軽額の既知の溶剤流延付加水の選ぶことができる。適当な付ば合ポリマーから選ぶことができる。適当な付

加ポリマーの例は、スチレン、、tーブチルスチレン、、tーブチルスチレン、スチレン、パーピニルカルバゾール、ピニルトルート、アクリレート、メチルメタクリレート、メチルアセテーのリン・オリロニトリル、おピニルリマーを含まれて、マーガリマーを含まれて、ボリマーの例は、ポリアである。適当なおし、ボリスの不必要では、およなを登りませる。活性物質の不必要のか好まである。活性物質の不必要のか好まである。活性物質の不必要のか好まである。活性物質の不必要なないに、結合剤は、層を形成する物質のが好ま物質を発展して50重量光度体を形成する好きしい活性物質

有機電界発光媒体を形成する好ましい活性物質 は各々フィルム形成物質であり、そんできる。極めて薄い欠陥のないできる。極いてできることができるというでなることができるとしずバイスと性能をながら、約50オングストロームができると表現させながら、約50オングストロームができるとで変素をしたボルフィリンを心を正孔を正孔を表現したボルフィリンを必要を強力したが、フィルム形成性芳香族第3アミン層と 送層(これはさらにトリアリールアミン層とテ

(103)

(104)

ラアリールジアミン暦とから成ることができる) として、そしてキレート化オキシノイド化合物を 電子注入及び輸送暦として使用したとすると、約 50から5000オングストロームの範囲にあるそれぞ れの膜厚が推奨され、そして 100から2000オング ストロームの範囲の膜厚が好ましい。一般に、有 機電界発光媒体の総体的厚みが少くとも約1000オ ングストロームであることが好ましい。

有機ELデバイスからアノードストリップを通して光を透過させることが意図される場合には、光透過性基板、例えば透明あるいは半透明なガラス板またはプラスチックフィルムの上に薄い電性ストリップを形成することによってこれを便宜に達成することができる。一つの形において、本発明の有機ELデバイスは、例えば先に引用の、Gurneeらの米国特許第 3.172.862号; Gurneeの米国特許第 3.173,050号; Dresner, "Double Injection Electroluminescence in Anthracene", RCA Review, 30巻、 322-334ページ、1969年; およびDresnerの米国特許第 3.710.167号によって開示

されるように、ガラス板上に被覆された錫酸化物またはインジウム錫酸化物から形成される光透過性アノードを含めるという歴史的慣行に従うことができる。基板として任意の光透過性ポリマーフィルムを使用できるが、 Gillsonの米国特許第2,733,367号および Swindellsの米国特許第2,941,104号はこの目的のために特に選ばれるポリマーフィルムを開示している。

and the same

しかし、もちろん、光透過性電極支持体または別々の重量せるフィルムまたは要素は、もしも必要ならば、放射トリミングフィルターとして作用するようにそれらの光吸収性を調節することができる。このような電極構成は、例えば Fleeingの米国特許第 4,035,686号によって開示されている。電極の光透過性導電性ストリップは、受けとる光の波長あるいはその倍数にほぼ等しい厚さで成膜される場合、干渉フィルターとして働くことができる。

歴史的慣行とは対照的に、一つの好ましい形において、本発明の有機BLデバイスはアノードを通して光を放射する。このことは、アノードが光透過性であるというデリードを開放し、そして、事実、本発明のこの形においてアノードは光に対して好ましくは不透明である。不透明アノードはアノードはアクトロン・ボルト(eV)よ

り大きい仕事関数を有する。適当なアノード金属 は以下で列挙する高(> 4 eV)仕事関数金属の中 から選ぶことができる。不透明アノードは、支持 体上の不透明な金属層から形成するかもしくは別 の金属箔またはシートとして形成することができ る。

(107)

(108)

で以て安定なBLデバイス性能を達成することが できず、そして本発明の好ましいカソードから排 除される(不純物濃度を別として)。

カソード用に利用できる低仕事関数金属(アルカリ金属以外)を元素周期表の周期により以下に列挙する。これらの金属は 0.5 eV仕事関数グループに分類される。ここに与えられている仕事関数はすべて、See, Physics of Semiconductor Devices. Wiley, N.Y., 1969年、 366ページからのものである。

周期	元_素	仕事関数, eVグル 一プによる
2	ベリリウム	3.5 - 4.0
3	マグネシウム	3.5 - 4.0
4	カルシウム	2.5 - 3.0
	スカンジウム	3.0 - 3.5
	チタン	3.5 - 4.0
	マンガン	3.5 - 4.0
	ガリウム	3.5 - 4.0

5	・ ストロンチウム	2.0 - 2.5
	イットリウム	3.0 - 3.5
	インジウム	3.5 - 4.0
6	パリウム	~ 2.5
	ランタン	3.0 - 3.5
	セリウム	2.5 - 3.0
	ブラセオジウム	2.5 - 3.0
	ネオジウム	3.0 - 3.5
	プロメシウム	3.0 - 3.5
	サマリウム	3.0 - 3.5
	ユーロピウム	2.5 - 3.0
	ガドリニウム	3.0 - 3.5
	テルピウム	3.0 - 3.5
	デイスプロシウム	3.0 - 3.5
	ホルミウム	3.0 - 3.5
	エルビウム	3.0 - 3.5
	ツーリウム	3.0 - 3.5
	イッテルピウム	2.5 - 3.0
	ルテチウム	3.0 - 3.5
	ハフニウム	~ 3.5

(110)

7	ラジウム	3.0 - 3.5
	アクチニウム	2.5 - 3.0
	トリウム	3.0 - 3.5
	ウラン	30 - 35

前記の列挙内容から、利用できる低仕事関数金 属はその大部分が第 II a 族あるいはアルカリ土類 族の金属、第Ⅲ族金属(稀土類金属、すなわち、 イットリウムおよびランタニドを含むが硼素とア ルミニウムを除く)およびアクチニド族金属に属 することが明らかである。アルカリ土類金属は、 それらの入手の容易さ、低コスト、取扱いやすさ、 および最小の環境・インパクトポテンシャル (adveres environmental impact potential)の故に、 本発明のELデバイスのカソードにおいて使用す るための低仕事関数金属の好ましい部類を構成す る。マグネシウムとカルシウムが特に好ましい。 著しく高価ではあるが、含まれる第Ⅲ族金属、特 に稀土類金属は類似の利点をもち、好ましい低仕 事関数金属として特に推奨される。3.0から4.0 eVの範囲の仕事関数を示す低仕事関数金属はより

低い仕事関数を示す金属より一般的に安定であり、 従って一般的に有利である。

カッードの 築においてカットでの金属におすの金属におすの金属におすの音を任任には、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないのの金属は、 ないの金属は、 ないの金属は、 ないの金属は、 ないの金属には、 ないの金属には、 ないの金属には、 ないの金属には、 ないの金属を補足する。 この金属を補足する。 この金属を補足する。

さもなければ、第二の金属は4eVよりも大きい 仕事関数をもつ各種の金属のどれかからでも選ぶ ことができる。かかる金属は、酸化に対してより 抵抗性である元素を含み、従って金属元素として より一般的に製作される。この第二金属は、それ が加工されたままの有機ELデバイス中で残留す るかぎり、そのデバイスの安定性へ寄与する。

(111)

(112)

カソード用に利用可能のより高い仕事関数 (4 eVまたはそれ以上) の金属を元素周期表の周期によって以下に列挙する。これらの金属は 0.5 eV仕事関数グループに分類される。

周期	_元_素_	仕事関数。eVグル ープによる
2	磁素	~ 4.5
	炭素	4.5 - 5.0
3	アルミニウム	4.0 - 4.5
4	バナジウム	4.0 - 4.5
	クロム	4.5 - 5.0
	鉄	4.0 - 4.5
	コパルト	4.0 - 4.5
	ニッケル	~ 4.5
	銅	4.0 - 4.5
	亜鉛	4.0 - 4.5
	ゲルマニウム	4.5 - 5.0
	砒素	5.0 - 5.5
	セレン	4.5 - 5.0

5	モリブデン	4.0 - 4.5
	テクネチウム	4.0 - 4.5
	ルテニウム	4.5 - 5.0
	ロジウム	4.5 - 5.0
	パラジウム	4.5 - 5.0
	銀	4.0 - 4.5
	カドミウム	4.0 - 4.5
	錫	4.0 - 4.5
	アンチモン	4.0 - 4.5
	テルル	4.5 - 5.0
6	タンタル	4.0 - 4.5
	タングステン	~ 4.5
	レニウム	~ 5.0
	オスミウム	4.5 - 5.0

	イリジウム	5.5 - 6.0
	イリジウム 白金	
•		5.5 - 6.0
	白金	5.5 - 6.0 $5.5 - 6.0$
٠	白 金 金	5.5 - 6.0 $5.5 - 6.0$ $4.5 - 5.0$
	白 金 金 水 銀	$5.5 - 6.0$ $5.5 - 6.0$ $4.5 - 5.0$ ~ 4.5
	白 金 金 水 銀 鉛	$5.5 - 6.0$ $5.5 - 6.0$ $4.5 - 5.0$ ~ 4.5 ~ 4.0

(113)

(114)

4 eVまたはそれ以上の仕事関数をもつ利用可能 金属を列挙した前記記載から、注目すべきより高 い仕事関数の金属はその大部分がアルミニウム、 第Ib族金属(銅、銀および金)、第IV・Vおよ びVI族の金属、および第8族遷移金属、特にこの 族の貴金属、によって占められることがわかる。 アルミニウム、銅、銀、金、錫、鉛、ピスマス、 テルルおよびアンチモンがカソード中へ超入れる ための特に好ましいより高い仕事関数の第二金属 である。

第二金属の選択をその仕事関数あるいは酸化安定性のいずれかを基準にして制限しないのにはいくつかの理由が存在する。第二の金属はカソードの極く少量成分にすぎない。第二の金属の主機能の一つは第一の低仕事関数金属を安定化することであり、そして、驚くべきことには、この第二の金属は自体の仕事関数および被酸化性と無関係にこの目的を達成する。

第二の金属が果たす第二の価値ある機能はカソ ードの厚みの関数としてカソードのシート抵抗を 下げることである。許容可能の低いシート抵抗水

第二の金属が果たすことが観察されている第三の価値ある機能は、ELデバイスの有機電界発光 媒体上への第一金属の真空蒸着を補助することで ある。真空蒸着において、第二の金属も被着され る時には、より少ない金属が真空室の壁面上に被

(115)

(116)

着され、そしてより多くの金属が有機電界発光媒体上に被着される。有機 B L デバイスを安定化し、薄膜カソードのシート抵抗を下げ、そして有機電界発光媒体による第一金属の受容を改善するという、第二金属の有効性は以下の実施例によって立証する。

2 %を占める。

第二の金属が比較的高い(少くとも4.0 eV)仕事関数の金属である時には、低仕事関数金属は好ましくはカソードの合計金属原子の50%よりも多くを占める。これは、カソードによる電子注入効率における低下を避けるためであり、しかしまた、第二の金属添加の利点はその第二の金属がカソードの合計金属原子の20%未満を占める時に本質的に実現されるということも観察に基いて予測される。

以上の論議はカソードを形成する金属の二成分の組合せに関してなされたものであるが、希望の場合には、3種、4種、さらにはそれより多数の金属の組合せが可能でありかつ使用できる金属の組合せが可能でありた第一の金属の割合は低仕事関数金属の任意の便宜的組合せによって占められることができる。

第二の金属は電気伝導性の向上のために依存さ

(118)

れ得るが、それらの金属はカソード金属の合計の小割合であるので、これらの金属が電気伝導性の形で存在することを不必要にする。第二の金属は、化合物(例えば、鉛、または例えば1種類もしたが、鉛、は例えば1種類もしたはないにがで、存在することができる。第一の低化率関数金属は、それらの金属がカソード金属の主要割合を占め、かつ電気伝導にとって頼りにされるので、元素状形態で用いられるのが好まし、若干の酸化が経時的におこってもよい。

第一の金属単独を基板上または有機電界発光媒体上へ被着させる際、溶液からであっても、あるいは好ましくは蒸気相からであっても、第一の金属の初期の空間的に分離された被着物はその後の被着のための核を形成する。引き続く被着によってこれらの核が微結晶へと成長せしめられる。その結果は微結晶の不均等でランダムな分布であり、不均質カソードが得られる。この核形成および成長段階の少くとも一段階、そして好ましくはその

両方の段階の間で第二の金属を提供することによ

金属の特定的選択に応じて、第二の金属は、それが基板とより相容性である場合には、不釣合いの数の核形成部位をつくり出すことができ、次いで第一の金属がこれらの核形成部位において沈着する。このような機構は、もしも事実ならば、第二の金属が存在する場合に、第一の金属が基板によって受理される効率は著しく増進されるという観察を説明するかもしれない。例えば、第二の金

(119)

(120)

属が同時被着されつつある時には、真空室の壁上で第一の金属のより少ない被着がおこるということが観察された。

カソードの第一および第二の金属は、同時被着される場合、均密にまぜ合わされる。すなわち、第一の金属あるいは第二の金属の被着がどちらも、残りの金属の少くとも一部が被着せしめられる前に完了することがない。第一および第二の金属の同時被着が一般的に有利である。さもなければ、第一および第二の金属を順次増分的に被着させることができ、これは並流被着に近似し得る。

必要とされるわけではないが、カソードは、それを一たん形成した後に後処理を行うことができる。例えば、カソードを基板の安定性限度内で選元雰囲気中で加熱してもよい。ワイヤボンディングあるいはデバイスの封止という慣用的付加工程のようなその他の作業も実施することができる。

〔実施例〕

本発明のマトリクスアドレス方式の有機ELデ

バイスの製作を以下の実施例で具体的に説明する。 実施例

a)ガラス上にインジウム錫酸化物(110) 層を有してなるアノード材料の透明シートをその寸法が10cm×10cmである正方形に切断した。この金属コーティングを0.05cmのアルミナ研磨剤で2.3分間にわたって研磨し、引き続いてイソプロピルアルコール及び蒸留水の1:1(容積)混合物中で超音波洗浄し、そして変素を吹き付けて乾燥した。その後、金属層の変形加工を行い、幅が275cmで中心間の間隔が400cm未満である薄膜平行アノードストリップの層を形成した。

b)次いで、芳香族第3アミン、1,1-ビス(4-ジーp-トリルアミノフェニル)シクロヘキサンの正孔注入及び輸送層(膜厚 750人)をアノードストリップの上に被著させた。この被着は、タングステンフィラメントによって加熱された石英ボートからのソース材料を蒸着することによって実施した。

(121)

- c) 発光帯域を構成する電子注入及び輸送層を 正孔注入及び輸送層の上に被着させた。アルミニ ウムトリスオキシン(CO-1)をホスト物質として使 用し、タングステンフィラメントによって加熱さ れた石英ポートから蒸着させた。
- d) 原子比が10: 1 である Mg 及び In のカソード層をその膜厚が 0.22 mmとなるまで発光帯域の最上層の上に被着させた。
- e)次いで、カソード層をアノードストリップの方向とは垂直の方向にホトリソグラフィーでパターニングして、幅 275mの平行ストリップを得た。ホトレジスト組成物は光重合及び架橋が可能な単量体、トリス(2ーアクリロイルエチル)ー1、3、5ーベンゼントリカルボキシレートであった。この単量体をフリーラジカルメカニズムによって重合させ、その際、増感剤と活性剤の反応を選じてフリーラジカルを発生させた。パターニング工程は次の通りである:
- 1) 単量体をその溶媒である2-エトキシエタ ノールからパターニングした。

(123)

- b) 有機電界発光媒体を無傷のまま保つ溶媒を 使用する。
- c) 常用のシャドーマスク法で可能なよりもより一層大きな面積をパターニングできる。
- d)シャドーマスクを用いるよりもかなりいさいとのセルサイズ、例えば 300 mm未満、が可能となる。さらに詳しく述べると、ピクセルサイズは 300 mm未満であることができる。同じように、ストリップでき、面にはストリップでき、の中心間隔を 400 mmのオーダーとすることができ、あるさいはストリップを記より狭い場合には上記よりもさらに狭く 最適には 100 mm未満であり、したがって、これに対応してより小さなピクセルを形成することができる。

〔発明の効果〕

本発明によれば、公知なデバイスの最も望ましい特徴と非常に小さなピクセル領域の形成を可能ならしめるマトリクスアドレス電極パターンとを

- 2) 単量体層を所望のパターンを与えるプロキシミティマスクを介してUV光に露光した。
- 3) アレイを2-エトキシェタノール中に数砂間にわたって浸漬することによって、未露光域内の非架構の単量体を除去した。
- 4)次いで、アレイを 100:1 水:硫酸溶液からなる酸エッチング浴中に浸漬することによって、得られた露出金属を除去した。
- 5)エッチング後、アレイを水中ですすぎ、そして余分の水を除くために回転させた。第1図に示したような最終パターン化アレイが得られた。このアレイにおいて、約 275 mmのピクセルサイズをもった3.8 cm×3.8 cmの活性セル領域の上に100ライン×100ラインのアレイが形成され、また、アノード及びカソードストリップの中心間の間隔は約 375 mmであった。

上記の実施例で説明したような手法を用いた結果、例えば以下に列挙するようないくつかの重要な利点が得られた:

a) 簡単なホトリソグラフィーを使用する。

(124)

組み合わせて有してなる有機電界発光デバイスが 成功裡に提供される。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明のBLデバイスの1態様をその 一部分について略示した拡大斜視図であり、そし て

第2 図及び第3 図は、それぞれ、本発明のEL デバイスの1態機において用いられる個々のピク セルを略示した拡大断面図である。

なお、これらの図面を略示した理由は、それぞれの層が非常に薄く、また、これらの層を正しい 縮尺で示すには層の膜厚の差が大きすぎたからで ある。

図中、 100は電界発光デバイスであり、102、 104及び 106はストリップであり、 108は絶縁性支持体であり、 200はデバイスであり、 203はストリップの断面であり、 205及び 207は層であり、 209はカソードのストリップ部分であり、 300はデバイスであり、 301はアノードのストリップであり、 305及び 307は層であり、そして 309はカ

(126)

C. T. Vine

ソードのストリップである。

特許出關人

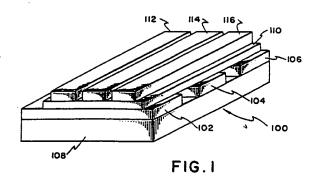
イーストマン コダック カンパニー

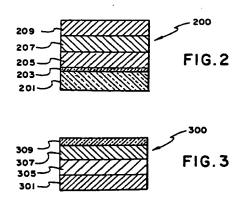
特許出顧代理人

 弁理士
 青
 木
 朗

 弁理士
 山
 口
 昭
 之

 弁理士
 西
 山
 雅
 也





(127)